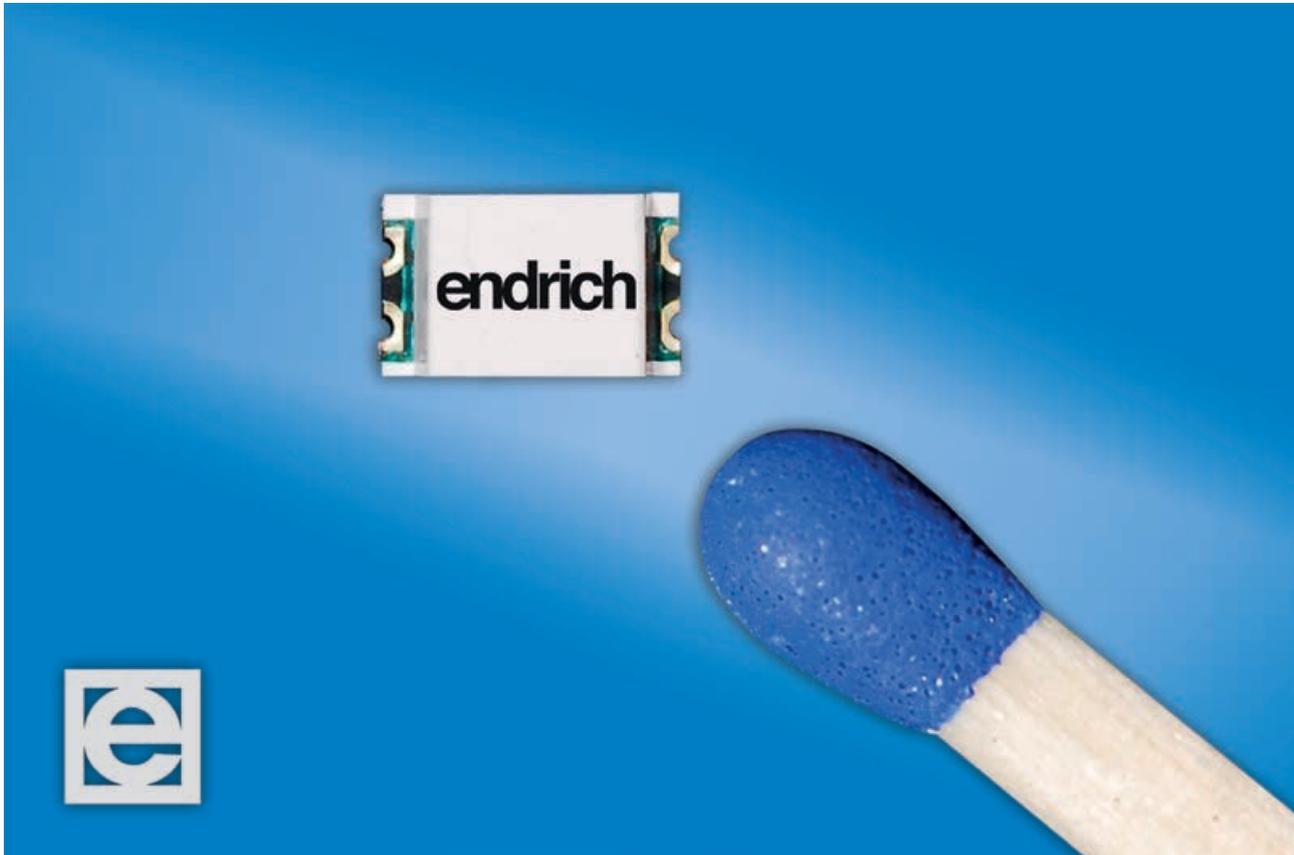


CT-MICROS NEUER 4-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER IM DFN-GEHÄUSE, MIT GERINGEM EINGANGSSTROM



Flachster Optokoppler der Welt

In der Optokoppler-Welt wird das Wort „klein“ möglicherweise nicht gerne verwendet, da die Hauptfunktion des Gehäuses darin besteht, eine physikalische Trennung zwischen zwei verschiedenen Potentialspannungen auf einem System vorzusehen. Wenn allerdings das derzeit schmalste Gehäuse nicht dünn genug ist für einen Kunden, und andere Hersteller sagen, dass dies momentan nicht möglich ist, setzen wird das „nicht mögliche“ durch die Einführung des weltweit kleinsten DFN Optokopplers um. Dieses brandneue ultra-schlanke Gehäuse hat eine 25% reduzierte Bauhöhe im Gegensatz zum momentan flachsten 2 mm hohen Mini-Flat-

Gehäuse oder sogar 65% dünner im Vergleich zu den auf dem Markt häufig anzutreffenden 4Pin DIP Photokopplern. Erreicht wird diese Dicke durch den Einsatz des patentierten Double-Molded Co-planar (DMCTM)-Technologie, die dazu beiträgt, eine Isolationsspannung von 2,5 kVrms/min. zu realisieren und dennoch einen physikalischen internen Isolationsabstand von 0,5 mm zu gewährleisten. Desweiteren verfügt der neue CTP17 Phototransistor-Optokoppler über eine garantierte Stromübertragungsrate (CTR) bei einem geringen Treibereingangstrom von nur 1mA.

CT-MICROS NEUER 4-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER IM DFN-GEHÄUSE, MIT GERINGEM EINGANGSSTROM

EIGENSCHAFTEN

- Patentiertes, doppelt geformtes Coplanar-Design (DMCTM), welches eine hohe Isolationsspannung und ein robustes ultraschlankes Gehäuse bietet.
- Garantierter CTR von 100 % - 300 % bei Testbedingungen von $I_F = 1 \text{ mA}$ / $V_{ce} = 5 \text{ V}$ für niedrige Stromflexibilität, Gesamtsystemleistung sowie Effizienz.
- geringe Durchlassspannung von typ. 1,24 V bei $I_F = 10 \text{ mA}$

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Isolationsspannung von 2,5 kVrms/min. mit physikalischer interner Isolation von 0,5 mm
- Hohe Betriebstemperatur von 110°C (125°C in Entwicklung) zur Verbesserung der Gesamtsicherheit
- Leicht erweiterbar auf Zwei- und Vierkanal mit einzigartigem DFN-Gehäuse-Design für kompakte System.
- 100 % bleifrei und RoHS konform, wahlweise halogenfrei um die Anforderungen zur grünen Umgebung zu erfüllen.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SYMBOL	PARAMETER	BEWERTUNGEN	EINHEIT	NOTIZEN
ABSOLUTE MAXIMALWERTE BEI 25°C				
Viso	Isolationsspannung	2500	V_{RMS}	
P_{TOT}	Gesamtverlustleistung	135	mW	
T_{OPR}	Betriebstemperatur	-55 ~ +125	°C	
T_{STG}	Lagertemperatur	-55 ~ +150	°C	
T_{SOL}	Löttemperatur	260	°C	

SYMBOL	PARAMETER	TESTBEDINGUNGEN	MIN	TYP	MAX	EINHEIT	NOTIZEN
EMITTERCHARAKTERISTIKEN							
V_F	Forward voltage	$I_F = 10 \text{ mA}$	-	1.24	1.4	V	
I_R	Reverse Current	$V_R = 6 \text{ V}$	-	-	5	μA	
C_{IN}	Input Capacitance	$f = 1 \text{ MHz}$	-	10	30	pF	